

令和4年9月吉日

委員各位

日本学術振興会

結晶加工と評価技術第145委員会

委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会

第176回研究会開催通知

日時： 2022年10月21日(金) 13:30~17:30

場所： オンライン開催

テーマ： 「SiCパワー半導体の結晶成長と評価、デバイス応用の最前線」

世話人： 土田秀一(電中研)、大谷昇(関西学院大学)、石川由加里(JFCC)

プログラム案：

13:10-13:30	委員総会	柿本 浩一(九州大学)
13:30-13:35	開会の挨拶	柿本 浩一(九州大学)
13:35-13:50	はじめに	土田秀一(電中研)
13:50-14:30	「高品質 SiC ウェハの開発と大口径化の動向」	馬淵雄一郎(昭和電工)
14:30-15:10	「車載用 SiC パワーデバイスの開発動向」	金村高司(ミライズテクノロジーズ)
15:10-15:40	休憩	
15:40-16:00	「SiC 結晶成長に対するマテリアルズインフォマティクス技術の開発」	杳掛健太朗(理化学研究所)
16:00-16:40	「SiC パワーデバイスの高性能化・高信頼性向上に向けた課題と取り組み」	矢野裕司(筑波大)
16:40-17:20	「SiC 結晶中の積層欠陥のモデル化とデバイスシミュレーション解析」	浅田聡志(電中研)
17:20-17:30	おわりに	大谷昇(関西学院大学)